

La₂O₃가 첨가된 ZPCCL계 세라믹스의 바리스터 특성

Varistor Characteristics of ZPCCL-Based Ceramics Doped with La₂O₃

정영철^{*}, 류정선, 남춘우
(Young-Chul Jung^{*}, Jung-Sun Ryu, Choon-Woo Nahm)

Abstract

The *I-V* characteristics and its stability of ZPCCL-based ceramic varistors doped with La₂O₃ in the range of 0.0~4.0 mol% were investigated. The density of ceramics was increased in the range of 4.7~5.8 g/cm³ with increasing La₂O₃ content. As La₂O₃ content is increased, the varistor voltage was decreased in the range of 503.49~9.42 V/mm up to 2.0 mol%, whereas increasing La₂O₃ content further caused it to increase. The ZPCCL-based varistors were characterized by nonlinearity, in which the nonlinear exponent is in the range of 3.05~82.43 and leakage current is in the range of 0.24~100.22 μA. Among ZPCCL-based varistors, 0.5 mol% added-varistors exhibited an excellent nonlinearity, in which the nonlinear exponent is 82.43 and the leakage current is 0.24 μA. Furthermore, they exhibited a high stability, in which the variation rate of the varistor voltage and the nonlinear exponent was -1.11% and -6.72%, respectively, under DC stress, such as (0.80 $V_{1mA}/90^\circ\text{C}/12\text{h}$) + (0.85 $V_{1mA}/115^\circ\text{C}/12\text{h}$) + (0.90 $V_{1mA}/120^\circ\text{C}/12\text{h}$) + (0.95 $V_{1mA}/125^\circ\text{C}/12\text{h}$) + (0.95 $V_{1mA}/150^\circ\text{C}/12\text{h}$).

Consequently, it was estimated that ZPCCL-based ceramics will be applied to development of Pr₆O₁₁ based ZnO varistors having a high performance.

Key Words : ZPCCL-based ceramic varistors, La₂O₃, Nonlinear exponent, Leakage current, DC stress, Stability

1. 서 론

바리스터는 매우 높은 비직선성의 *I-V* 특성을 가지는 세라믹 반도체 저항 소자이다. 이러한 비직선성을 이용하여 각종 씨지로부터 전자장치나 전력설비 보호에 매우 폭넓게 응용되고 있다[1-2].

최근에는 비직선성, 용답성, 안정성 등의 바리스터 특성이 우수한 것으로 알려진 Pr₆O₁₁계 ZnO 바리스터에 대한 연구가 국내외적으로 활발히 진행되고 있다. 특히 국내에서는 4~5 성분계 바리스터에 대해 연구가 시도되고 있다[3-4]. 지금까지 연구된 5성분 ZnO-Pr₆O₁₁-CoO-Cr₂O₃-M₂O₃ (M = Er, Dy)계 바리

스터의 특징은 높은 비직선성을 나타내는 바리스터는 밀도가 낮아 안정성이 다소 낮았으며, 높은 안정성을 나타내는 바리스터는 밀도는 높은 비직선성이 다소 낮았다. 비교적 높은 비직선성과 안정성을 유지하는데는 1350°C 정도의 고온소결이 필요한 것으로 나타났다[5]. 따라서 소결온도를 낮추면서 높은 비직선성과 안정성을 나타내는 바리스터가 현 시점에서 연구의 필요성이 요구되고 있다.

이러한 관점에서 본 연구에서는 상기의 5 성분계의 M = La로 한 ZPCCL계 ZnO 바리스터의 La₂O₃ 첨가량에 따른 미세구조, *I-V* 특성 및 안정성을 조사하여 그 실용 가능성을 탐색하였다.

2. 실험 방법

(98.0-x) mol% ZnO+0.5 mol% Pr₆O₁₁+1.0 mol% CoO+0.5 mol% Cr₂O₃+x mol% La₂O₃ (x = 0.0~4.0)

* 동의대학교 전기공학과
(부산시 진구 가야동 산24번지)

Tel : 051-890-1669, Fax : 051-890-1664
E-mail : cwnahm@dongeui.ac.kr

의 시료 조성식에 따라 전자저울로 0.1 mg의 오차범위까지 평량하였다. 평량된 시료를 24시간 불밀하였고, 120°C에서 12시간동안 건조시킨 후, 750°C에서 2시간 하소하였다. 80 MPa 압력하에서 직경이 10 mm, 두께가 2.0 mm가 되게 성형한 후, 같은 조성의 분위기 분말과 함께 도가니에 넣어 같은 온도 승·하강율 (4°C/min)인 1300°C에서 1시간씩 소결하였다. 소결된 시편을 1.0 mm 두께로 연마한 후, Ag 전극을 실크스크린 기법으로 직경이 5 mm되게 도포한 다음, 600°C에서 10분간 열처리하였다.

I-V 특성은 실온(298K)에서 Current/Voltage Source Measure Unit (Keithley 237)을 사용하여 전류 밀도 50 mA/cm²까지 전도특성을 측정하였다. 바리스터 전압 (V_{1mA})은 전류밀도가 1 mA/cm²일 때의 전압으로, 누설전류 (I_t)는 바리스터 전압의 80% 전압에서 각각 측정되었으며, 비직선 지수 (α)는 $\alpha = (\log J_2 - \log J_1) / (\log E_2 - \log E_1)$ 의 관계식으로부터 구하였다. 여기서 E_1 과 E_2 는 $J_1 = 1 \text{ mA/cm}^2$ 와 $J_2 = 10 \text{ mA/cm}^2$ 에 각각 대응되는 전계이다.

스트레스 인가전의 *I-V* 특성을 측정한 시편에 다음과 같은 각각의 DC 스트레스를 인가하였으며, 각 스트레스 인가시 동시에 1분 간격으로 전류가 측정, 기록되도록 하였다.

1차 스트레스- 0.80 $V_{1mA}/90^\circ\text{C}/12\text{h}$

2차 스트레스- 0.85 $V_{1mA}/115^\circ\text{C}/12\text{h}$

3차 스트레스- 0.90 $V_{1mA}/120^\circ\text{C}/12\text{h}$

4차 스트레스- 0.95 $V_{1mA}/125^\circ\text{C}/12\text{h}$

5차 스트레스- 0.95 $V_{1mA}/150^\circ\text{C}/12\text{h}$

측정하였으며, 계속적으로 2, 3, 4, 5차 스트레스를 바리스터에 인가하여 1차 스트레스와 동일하게 전기적 특성을 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1은 La_2O_3 첨가에 따른 바리스터의 미세구조 사진으로 첨가량이 증가함에 따라 결정립 크기가 각각 4.00, 6.90, 7.87, 8.51 μm 로 증가하였으나, 4.0 mol% 첨가시 감소한 것으로 나타났다.

첨가량에 따른 밀도를 보면 각각 4.712, 5.400, 5.768, 5.774, 5.815 g/cm^3 로 증가하였다. 특히 La_2O_3 가 4.0 mol% 첨가시는 이론밀도 (5.78) 보다 높은 치밀성을 나타내었는데 이는 La_2O_3 첨가에 따른 ZnO 결정립 성장 촉진 및 액상 소결성의 향상에 따른 결과로 사료된다.

그림 2는 La_2O_3 첨가량에 따른 전류밀도-전계 특성을 나타낸 것으로 전압에 따라 전류가 선형적으로 증가하는 전향복 영역과 전류가 급격히 증가하는 항복 영역으로 대별됨을 알 수 있다. La_2O_3 가 0.5 mol% 첨가시 *J-E* 특성 곡선의 knee 부위가 더욱 날카로워졌으나 La_2O_3 첨가에 따라 비직선성이 저하함을 외형적으로 알 수 있다.

그림 3(a)는 La_2O_3 첨가량에 따른 바리스터 전압 (V_{1mA}) 및 입계당 바리스터 전압 (V_{gb})의 변화를 나타낸 것으로 V_{1mA} 은 첨가량이 증가할수록 급격히 감소하여 2.0 mol%에서는 9.42 V/mm로 대단히 낮은 값을 나타내었고, 4.0 mol%에서는 다시 증가하는 경

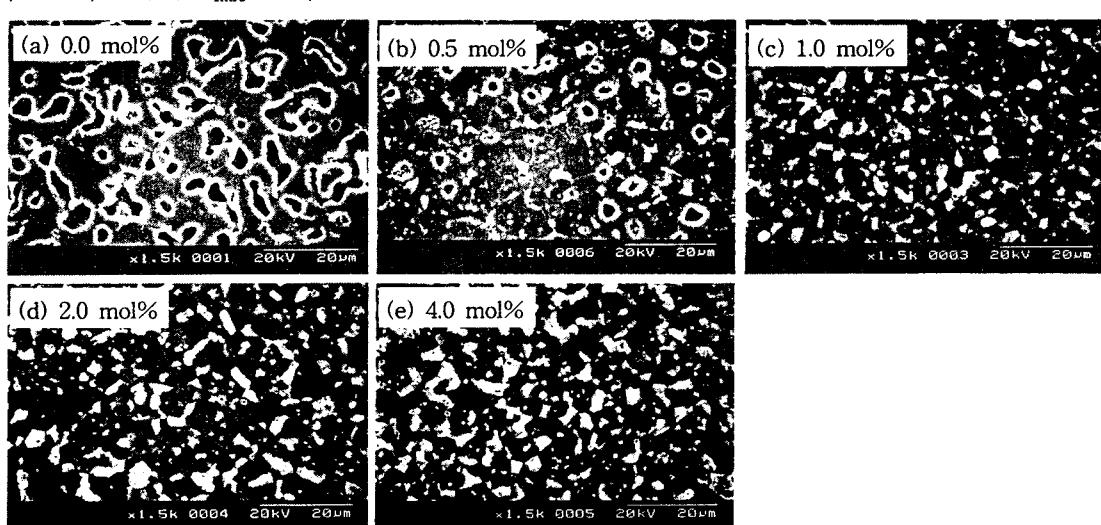


그림 1. La_2O_3 첨가량에 따른 ZPCCL계 바리스터의 미세구조.

Fig. 1. The micrographs of ZPCCL-based ceramics with La_2O_3 content.

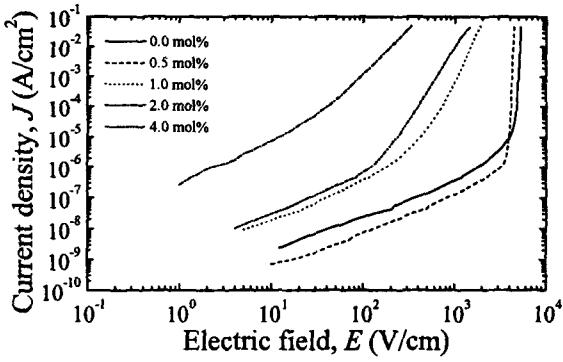


그림 2. La_2O_3 첨가량에 따른 ZPCCL계 바리스터의 J - E 특성.

Fig. 2. The J - E characteristics of ZPCCL-based varistors with La_2O_3 content.

향을 나타내었다. 한편 V_{gb} 는 통상적으로 $V_{gb} = 2 \sim 4 \text{ V/gb}$ 정도인데, La_2O_3 를 0.0, 0.5 mol% 첨가시는 이와 잘 부합하였으나, 1.0~4.0 mol% 첨가시는 아주 낮은 값을 나타내었다. 이는 “good barrier” 와 “bad barrier”에서 오는 장벽의 특성에 따른 결과라 사료된다. 이러한 장벽특성은 비직선 지수에도 영향을 미치는 것으로 나타났다.

그림 3(b)는 La_2O_3 첨가량에 따른 비직선 지수 (α)와 누설전류 (I_t)의 변화를 나타낸 것이다. La_2O_3 가 첨가되지 않은 바리스터도 높은 비직선성을 나타내었지만 0.5 mol% 첨가시 $\alpha = 82.43$, $I_t = 0.24 \mu\text{A}$ 로 비직선성이 크게 향상되었다. 이러한 결과는 보기 드문 것으로, 높이 평가되어야 할 것으로 판단된다. 그러나 0.5 mol% 이상 첨가시는 예상할 수 없을 정도로 $\alpha = 10$ 이하, $I_t = 50 \mu\text{A}$ 이상으로 비직선성이 크게 저하되는 결과를 가져왔다. 따라서 La_2O_3 첨가량의 선택에 따라 I - V 특성의 비직선성의 고저가 극명하게 드러남으로서 La_2O_3 첨가량이 I - V 특성에 미치는 영향이 아주 큼을 쉽게 확인할 수 있다. 여기서 주목되는 점은 0.5 mol% 첨가된 바리스터는 기존의 $\text{ZnO}-\text{Pr}_6\text{O}_{11}-\text{CoO}-\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{M}_2\text{O}_3$ ($M = \text{Er}, \text{Dy}$)계 바리스터와 같은 조성비에서 비교하여 훨씬 높은 V_{1mA} 와 α , 그리고 낮은 I_t 값을 나타냄으로써 써지 흡수기 및 피뢰기 등에 다양하게 응용될 수 있을 것으로 판단된다. 자세한 I - V 특성 파라미터 값은 표 1에 나타내었다.

그림 4는 우수한 비직선성을 나타내는 0.5 mol% La_2O_3 를 첨가한 바리스터에 한해 안정성을 조사하기 위해 연속적인 DC 스트레스를 인가하고 그에 따른 누설전류의 변화를 나타낸 것이다. La_2O_3 를 첨가하지 않은 바리스터는 비직선성은 우수하나 낮은 밀도

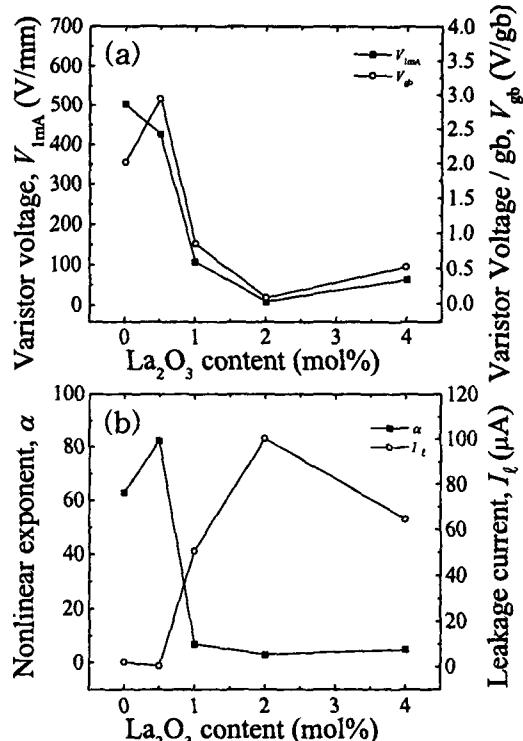


그림 3. La_2O_3 첨가량에 따른 ZPCCL계 바리스터의 I - V 특성 파라미터. (a) 바리스터 전압과 입계당 전압, (b) 비직선 지수와 누설전류.

Fig. 3. The I - V characteristic parameters of ZPCCL-based varistors with La_2O_3 content. (a) varistor voltage and varistor voltage per grain boundary, and (b) nonlinear exponent and leakage current.

표 1. La_2O_3 첨가량에 따른 ZPCCL계 세라믹스의 I - V 특성 파라미터.

Table 1. The I - V characteristic parameters of ZPCCL-based varistors with La_2O_3 content.

La_2O_3 content (mol%)	V_{1mA} (V/mm)	V_{gb} (V/gb)	α	I_t (μA)
0.0	503.49	2.01	63.04	2.06
0.5	426.80	2.94	82.43	0.24
1.0	108.00	0.85	7.08	50.59
2.0	9.42	0.08	3.05	100.22
4.0	63.54	0.52	4.97	64.54

로 인하여 1차 스트레스에서 열폭주 현상을 일으켰다. La_2O_3 가 0.5 mol% 첨가된 바리스터는 이론밀도의 93.43%에 달하는 치밀성으로 인하여 가혹한 5차

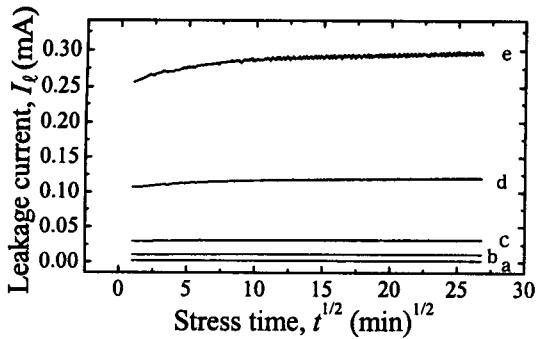


그림 4. La_2O_3 을 0.5 mol% 첨가한 ZPCCL계 바리스터의 DC 스트레스 동안의 누설전류. a: 1차, b: 2차, c: 3차, d: 4차, e: 5차.

Fig. 4. The leakage current of during various DC stresses of the ZPCCL-based varistors doped with 0.5 mol% La_2O_3 . a: 1st, b: 2nd, c: 3rd, d: 4th, and e: 5th.

스트레스에서도 열폭주 현상이 일어나지 않았으며 1, 2, 3차 스트레스까지는 누설전류 변화가 작고 스트레스 인가동안 거의 일정한 것으로 나타났다.

그림 5는 DC 스트레스 후의 $I-V$ 특성 파라미터의 변화율을 나타낸 것으로 안정성 평가의 가장 중요한 인자인 바리스터 전압 변화율 ($\% \Delta V_{\text{ImA}}$)은 5차 스트레스 후에도 -1.11% 로 매우 적었고, 비직선 지수 변화율 ($\% \Delta \alpha$)도 -6.72% 정도로 낮은 것으로 나타났다. 그리고 누설전류 변화율 ($\% \Delta I_t$)은 429.17% 로 매우 높았으나 5차 스트레스 후의 누설전류가 $1.27 \mu\text{A}$ 에 불과해서 우수한 안정성을 나타내는 결과로 판단된다.

4. 결론

$\text{ZnO}-\text{Pr}_6\text{O}_{11}-\text{CoO}-\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{La}_2\text{O}_3$ 로 구성되는 ZPCCL계 ZnO 바리스터의 $I-V$ 특성 및 안정성을 La_2O_3 첨가량에 따라 조사하여 얻은 결론은 다음과 같다.

1. 바리스터 전압은 La_2O_3 첨가량이 2.0 mol%까지 증가함에 따라 $503.49 \sim 9.42 \text{ V/mm}$ 범위로 급격히 감소하였으나, 4.0 mol%에서 다시 증가하는 결과를 나타내었다. 특히 0.5 mol% 첨가시 426.80 V/mm 의 높은 바리스터 전압을 나타내었다.
2. 비직선 지수는 La_2O_3 첨가량이 0.5 mol%까지 증가함에 따라 증가하였으며, 0.5 mol%에서 최대치 82.43으로 매우 우수한 값을 나타내었다. 더 많은 첨가는 비직선성을 크게 저하시켰다.
3. 누설전류는 비직선 지수와 상반대는 특성을 나타되었으며, 0.5 mol% La_2O_3 첨가시 $0.24 \mu\text{A}$ 로서 매우 낮은 값을 나타내었다.

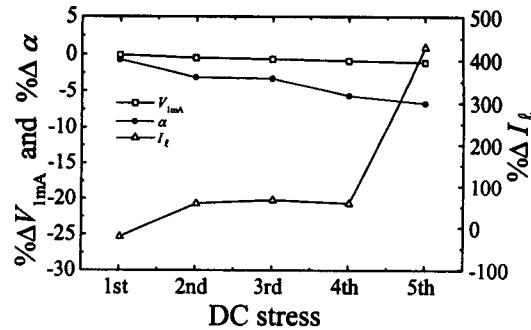


그림 5. La_2O_3 가 0.5 mol% 첨가된 ZPCCL계 바리스터의 DC 스트레스후의 $I-V$ 특성 파라미터 변화율.

Fig. 5. The variation rate of $I-V$ characteristic parameters of ZPCCL-based varistors doped with 0.5 mol% La_2O_3 after DC stress.

4. 0.5 mol% La_2O_3 첨가된 바리스터는 미세구조적으로 밀도가 비교적 높고 누설전류가 낮아 아주 가혹한 5차에 걸친 DC 스트레스 하에서도 바리스터 전압 변화율이 -1.11% , 비직선 지수 변화율이 -6.72% , 누설전류 변화율이 429.17% 를 나타냄으로서 우수한 안정성을 나타내었다.

결론적으로 La_2O_3 가 첨가된 Pr_6O_{11} 계 ZnO 바리스터는 비교적 낮은 소결은도에서도 미세구조적, 전기적 특성 및 안정성이 양호하여 향후에 La_2O_3 가 Pr_6O_{11} 계 ZnO 바리스터 개발에 유용하게 사용되어 질 것으로 확신한다.

참고 문헌

- [1] ニューケラスシリーズ 編集委員會, “半導体セラミクスとその應用,” 學獻社, pp. 149-161, 1990.
- [2] 日本電氣學會, “酸化亞鉛避電氣の特性と評價試法,” 電氣學會技術報告, 第474号, 1993.
- [3] C.-W. Nahm, C.-H. Park, and H.-S. Yoon, “Highly Stable Nonohmic Characteristics of $\text{ZnO}-\text{Pr}_6\text{O}_{11}-\text{CoO}-\text{Dy}_2\text{O}_3$ Based Varistors,” J. Mater. Sci. Lett., Vol. 19, pp. 725-727, 2000.
- [4] C.-W. Nahm and C.-H. Park, “Microstructure, Electrical Properties, Degradation Behavior of Praseodymium-Based Doped with Y_2O_3 ,” J. Mat. Sci., Vol. 35, pp. 3037-3042, 2000.
- [5] C.-W. Nahm, “The Nonlinear Properties and Stability of $\text{ZnO}-\text{Pr}_6\text{O}_{11}-\text{CoO}-\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{Er}_2\text{O}_3$ Ceramic Varistors,” Mater. Lett., Vol. 47, No. 3, pp. 182-187. 2001.